

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama  
Sidang Akademik 1995/96

Oktober/November 1995

ZSE 423 - Spektroskopi

Masa : [3 jam]

---

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab LIMA soalan sahaja, DUA daripada Bahagian A dan TIGA daripada Bahagian B. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia kecuali Bahagian A.

**BAHAGIAN A**

1. Spektrum molekul dwiatom disebabkan oleh tiga jenis peralihan yang jelas iaitu: elektronik, getaran dan putaran. Tuliskan satu paragraf pendek bagi setiap jenis peralihan dan nyatakan di kawasan mana di dalam spektrum elektromagnet garisan-garisan peralihan tersebut biasanya berlaku. (30/100)

Lakarkan satu bentuk graf tenaga keupayaan  $V(r)$  melawan jarak antara atom  $r$  di dalam suatu molekul dwiatom dan tunjukkan jarak antara atom di dalam keadaan keseimbangan  $r_0$  di dalam lakaran anda. (10/100)

Terangkan dengan menggunakan lakaran anda kenapa peralihan-peralihan getaran boleh diperihalkan menggunakan pengayun harmonik mudah. Dengan anggapan bahawa jisim yang digunakan ialah jisim terkurang  $\mu = m_1m_2/(m_1 + m_2)$  dengan  $m_1$  dan  $m_2$  ialah jisim-jisim individu, dapatkan satu formula untuk frekuensi pengayun klasik  $\omega$  di dalam sebutan  $\mu$  dan pembezaan kedua  $d^2V/dr^2$ . (20/100)

Tuliskan formula untuk paras-paras tenaga kuantum  $E_n$  yang bersangkutan. (10/100)

Bandingkan molekul-molekul  $H_2$ ,  $HD$  dan  $D_2$  di mana D ialah deuterium. Dengan anggapan bahawa  $m_D = 2m_H$ , kira nisbah-nisbah  $\mu(HD)/\mu(H_2)$  dan  $\mu(D_2)/\mu(H_2)$ . Dengan anggapan bahawa  $V(r)$  sama bagi setiap kes, nyatakan dengan tepat bagaimana skima paras tenaga getaran dan peralihan-peralihan spektrum yang bersangkutan itu dihubungkan. (20/100)

....2

Dengan anggapan bahawa momen inersia ialah  $2\mu r_0^2$ , kira nisbah-nisbah antara sebutan-sebutan setara di dalam skima tenaga putaran bagi H<sub>2</sub>, HD dan D<sub>2</sub>.

(10/100)

2. Titik-titik kuantum, yang merupakan sebagai bintik-bintik kecil dihasilkan melalui proses litografi, sekarang ini menjadi bidang yang diminati di dalam fizik semikonduktor. Modelkan satu titik kuantum sebagai satu kotak segiempat dengan panjang a pada arah-arah x dan y dan panjang b pada arah z. Nilai a dan b biasanya pendek sedikit sahaja daripada jarak-jarak antara atom. Anggapkan bahawa keupayaan ialah sifar di dalam kotak dan tak terhingga diluar kotak.

Bincangkan dengan terperinci spektroskopi elektron-tunggal satu titik kuantum GaAs jenis-n. Aturkan perbincangan anda mengikut struktur berikut:

- (a) Tuliskan skima paras tenaga di dalam sebutan nombor-nombor kuantum n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> dan n<sub>3</sub> yang dihubungkan dengan x, y dan z. Buat satu anggaran tenaga pada keadaan dasar di dalam unit eV bagi nilai a = b = 10 nm. Berapakah nilai a, dengan a = b, bagi serapan tenaga terendah daripada keadaan dasar yang dikaitkan dengan cahaya nampak dengan panjang gelombang 500 nm? (35/100)
- (b) Jikalau titik kuantum tersebut dibuat di atas suatu substrat (kebiasaananya) maka arah yang termudah untuk sinaran menuju padanya ialah mengikut arah z. Dapatkan peralihan-peralihan yang dibenarkan daripada keadaan dasar dan dapatkan juga petua-petua pemilihan pengutuban (jika ada). (15/100)

Buktikan bahawa elemen matriks dwikutub bagi garis serapan terendah daripada keadaan dasar ialah  $16a/9\pi^2$ . (25/100)

- (c) Apakah maklumat tambahan yang boleh diperolehi daripada spektrum yang didapati daripada sinaran yang datang daripada arah-arah lain? Bagi sinaran yang datang, katakan mengikut arah x, dapatkan peralihan-peralihan yang dibenarkan dan dapatkan juga petua-petua pemilihan. (25/100)

[Fungsi-fungsi eigen termormal di dalam suatu kotak |x| < d/2 ialah:

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= (2/d)^{1/2} \cos(n\pi x/d) & n &= 1, 3, 5, \dots \\ \psi_n(x) &= (2/d)^{1/2} \sin(n\pi x/d) & n &= 2, 4, 6, \dots\end{aligned}$$

Elemen matriks dwikutub ialah  $\int \psi_1^* \mathbf{s} \cdot \mathbf{r} \psi_2 d^3r$  di mana vektor unit  $\mathbf{s}$  ialah arah pengutuban.

$$\begin{aligned}\cos(\theta) \sin(\theta) &= [\sin(m+1)\theta + \sin(m-1)\theta]/2 \\ \int z \sin az dz &= (\sin az)/a^2 - (z \cos az)/a\end{aligned}$$

Jisim berkesan elektron di dalam GaAs ialah m\* = 0.067 m<sub>e</sub>.]

....3

3. Terangkan secara ringkas idea tentang medan swa-konsisten yang digunakan untuk mengira skima aras tenaga bagi satu atom banyak-elektron. (10/100)

Konfigurasi elektronik bagi keadaan dasar atom C ialah  $K2s^22p^2$ . Terangkan secara terperinci maksud ayat tersebut. (10/100)

Kenapakah spesifikasi konfigurasi adalah tidak lengkap untuk dijadikan sebagai satu takrifan keadaan elektronik? (10/100)

Jumlah momentum sudut  $L$  ialah hasilambah  $L_1$  dan  $L_2$  :  $L = L_1 + L_2$ . Nyatakan hukum-hukum yang menentukan nilai-nilai jumlah nombor kuantum  $L$  dan nombor azimuth  $M$  yang bersangkutan yang boleh diperolehi menggunakan sebutan  $L_1$  dan  $L_2$ . Buktikan bahawa jumlah bilangan keadaan di dalam keterangan  $(L, M)$  sama seperti keterangan  $(L_1, L_2)$ . (30/100)

Jelaskan bagaimana hukum-hukum bagi tambahan momentum sudut digunakan untuk menjanakan sebutan-sebutan yang boleh berlaku bagi satu konfigurasi elektronik yang diberikan. (10/100)

Dapatkan semua sebutan bagi suatu konfigurasi  $s^1d^1$ . Gunakan hukum-hukum Hund untuk menentukan nilai  $S$  dan  $L$  bagi sebutan-sebutan tenaga terendah yang boleh berlaku. Apakah interaksi fizikal yang menentukan nilai  $J$  yang bersangkutan dengan tenaga terendah? (30/100)

## BAHAGIAN B

- 4.(a) Terangkan hubungan antara interferogram terhingga dari sumber monokromatik dengan spektrum yang diperolehi. Jelaskan cara untuk memperbaiki spektrum tersebut. (30/100)

- (b) Jelaskan hubungan selang persampelan dengan fenomena konvolusi spektrum. (40/100)

- (c) Bincangkan maklumat-maklumat yang boleh diperolehi daripada spektrum infra merah jauh suatu bahan semikonduktor daripada kumpulan III-V seperti GaAs. (30/100)

- 5.(a) [i] Lakarkan fungsi dwielektrik ( $\epsilon$ ) GaAs di persekitaran jalur reststrahlen. Terangkan lakaran tersebut dan labelkan fonon TO, LO, nilai-nilai  $\epsilon_\infty$  dan  $\epsilon_0$ .

- [ii] Terangkan faktor kelembapan keatas lakaran (i) di atas dan kesan suhu terhadap kelembapan. (50/100)

....4

- (b) Bincangkan komponen Stokes dan anti-Stokes menggunakan persamaan dwikutub elektrik teraruh di dalam penyerakan Raman. Terangkan maksud ungkapan *fonon TO anti-Stokes ialah pada  $61 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$* . (30/100)
- (c) Lukiskan tatarajah penyerakan Raman  $90^\circ$  dan  $180^\circ$ . Terangkan kedua-dua kegunaannya dan sebab-sebab mengapa salah satu daripadanya digunakan untuk mempelajari sampel semikonduktor AlGaAs menggunakan laser ion Ar<sup>+</sup>. (20/100)
- 6.(a) Terangkan bagaimana penjanaan harmonik boleh berlaku. (20/100)
- (b) Bincangkan bagaimana sel Pockels beroperasi di dalam laser tersuis-Q dan kegunaan laser tersebut. (50/100)
- (c) Jelaskan prinsip
- [i] penceraian 2-foton
  - [ii] laser He-Ne asas
- (30/100)

## TERJEMAHAN

BAHAGIAN A

1. The spectrum of a diatomic molecule is due to three distinct kinds of transition: electronic, vibrational and rotational. Write a short paragraph on each type of transition and state in which part of the electromagnetic spectrum the corresponding lines typically occur. (30/100)

Sketch the form of the graph of potential energy  $V(r)$  versus interatomic separation  $r$  in a diatomic molecule and identify the equilibrium separation distance  $r_0$ . (10/100)

Use your graph to explain why vibrational transitions are described by the simple harmonic oscillator. Assuming that the mass that appears is the reduced mass  $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$  where  $m_1$  and  $m_2$  are the individual masses, find the expression for the classical oscillator frequency  $\omega$  in terms of  $\mu$  and the second derivative  $d^2V/dr^2$ . (20/100)

Write down the expression for the corresponding quantum energy levels  $E_n$ . (10/100)

Compare the  $H_2$ , HD and  $D_2$  molecules, where D is deuterium. Assuming that  $m_D = 2m_H$ , find the ratios  $\mu(HD)/\mu(H_2)$  and  $\mu(D_2)/\mu(H_2)$ . Assuming that  $V(r)$  is the same in each case, state precisely how the vibrational energy-level schemes and corresponding spectral transitions are related. (20/100)

Assuming that the moment of inertia is  $2\mu r_0^2$ , find the ratios between equivalent terms in the rotational-energy schemes of  $H_2$ , HD and  $D_2$ . (10/100)

2. Quantum dots, which are very small islands produced by lithographic processing, are of current interest in semiconductor physics. Model a quantum dot as a rectangular box with side lengths  $a$  in the x and y directions and  $b$  in the z direction. Typically  $a$  and  $b$  are not much larger than interatomic distances. Assume that the potential is zero inside the box and infinite outside it.

Discuss in detail the single-electron spectroscopy of an n-type GaAs quantum dot. Structure your discussion as follows:

(a) Write down the energy-level scheme in terms of quantum numbers  $n_1$ ,  $n_2$  and  $n_3$  corresponding to x, y and z. Estimate the ground-state energy in eV for  $a = b = 10$  nm. For what value of  $a$ , with  $a = b$  does the lowest-energy absorption from the ground state correspond to the visible wavelength 500 nm? (35/100)

(b) If the dot is prepared on a substrate (as it always is) then the easiest direction for incident radiation is along z. Find the allowed transitions from the ground state and the polarization selection rules (if any). (15/100)

Prove that the dipole matrix element for the lowest absorption line from the ground state is  $16a/9\pi^2$ . (25/100)

(c) What additional information can be obtained from spectra with other directions of incidence? For grazing incidence, along x say, find the allowed transitions and selection rules. (25/100)

[ The normalised eigenfunctions in a box  $|x| < d/2$  are

$$\psi_n(x) = (2/d)^{1/2} \cos(n\pi x/d) \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

$$\psi_n(x) = (2/d)^{1/2} \sin(n\pi x/d) \quad n = 2, 4, 6, \dots$$

The dipole matrix element is  $\int \psi_1^* \epsilon \cdot r \psi_2 d^3r$  where the unit vector  $\epsilon$  is the polarization direction.

$$\cos(\theta) \sin(m\theta) = [\sin(m+1)\theta + \sin(m-1)\theta]/2$$

$$\int z \sin \alpha z dz = (\sin \alpha z)/\alpha^2 - (z \cos \alpha z)/\alpha$$

Electron effective mass in GaAs is  $m^* = 0.067m_e$ .

]

3. Explain briefly the idea of the self-consistent field that is used in calculating the energy level scheme of a many-electron atom. (10/100)

The electronic configuration of the ground state of the C atom is K2s<sup>2</sup>2p<sup>2</sup>. Explain in detail what this means. (10/100)

Why is a specification of the configuration insufficient as a definition of the electronic state? (10/100)

The total angular momentum  $L$  is the sum of  $L_1$  and  $L_2$ :  $L = L_1 + L_2$ . State the rules governing possible values of the total quantum number  $L$  and the corresponding azimuthal number  $M$  in terms of  $L_1$  and  $L_2$ . Verify that the total number of states in the  $(L, M)$  description is the same as in the  $(L_1, L_2)$  description. (30/100)

Explain how the rules for addition of angular momentum are used to generate the possible terms for a given electronic configuration. (10/100)

Find all the terms for an s<sup>1</sup>d<sup>1</sup> configuration. Apply Hund's rules to determine the S and L values of possible lowest-energy terms. What physical interaction governs the value of J corresponding to the lowest energy? (30/100)